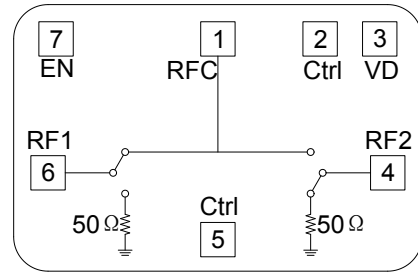


特点:

- 吸收式 SP2T 开关
- 频率: DC~4GHz
- 插入损耗: 1.0dB
- 隔离度: 50dB
- 工作温度: -55~+85°C
- 芯片尺寸: 1.38×1.24×0.1mm

功能框图

性能参数: (T_A=+25°C, V_{Ctrl}=0/+3.3V)

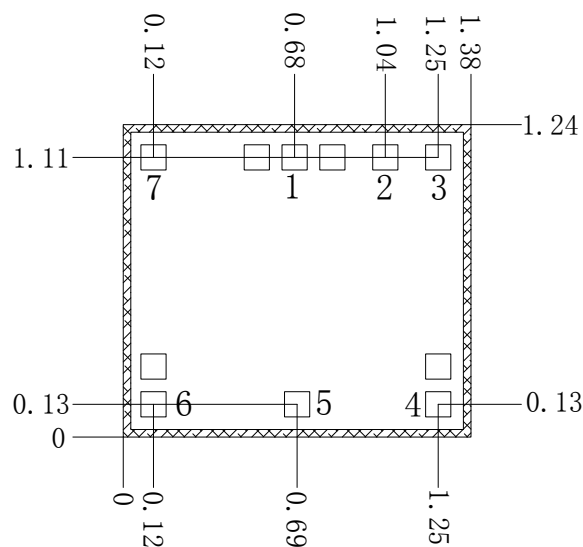
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	Z _{in} =Z _{out} =50Ω P _{in} = 0dBm V _{Ctrl} =0/+3.3V	DC		4	GHz	
插入损耗	IL			1.0	1.2	dB	
隔离度	ISO		40	50		dB	
输入驻波	VSWR _i			1.5	2		
输出驻波	VSWR _o			1.5	2		
电源电压	VD		4.75	+5.0	+5.25	V	
开关时间	t				150	ns	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+5.5	V	最大输入功率	+27	dBm
控制电压	低电平: 0~0.5	V	贮存温度	-55~+150	°C
	高电平: 3~5				

芯片尺寸图:

单位: mm



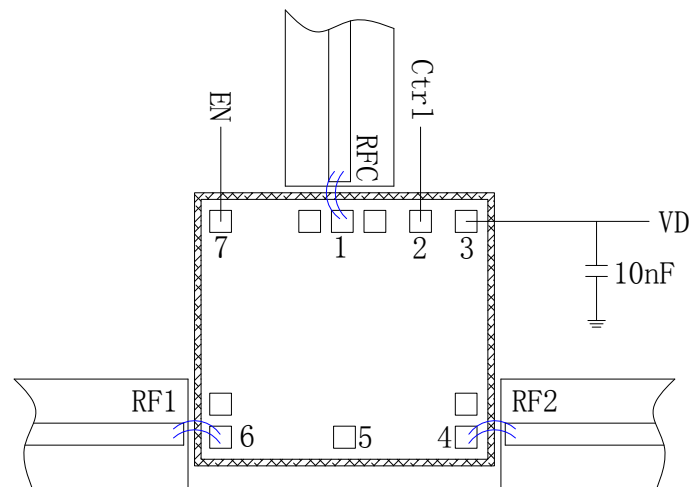
注: 典型键合焊盘尺寸为 100*100um

引脚定义:

引脚	定义	描述
1	RFC	射频输入, DC 耦合, 需外接隔直电容
2, 5	Ctrl	开关控制端
3	VD	TTL 驱动电路电源端, 接+5V 电源, 需外接 10nF 旁路电容
4, 6	RF2, RF1	射频输出, DC 耦合, 需外接隔直电容
7	EN	开关芯片使能端
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

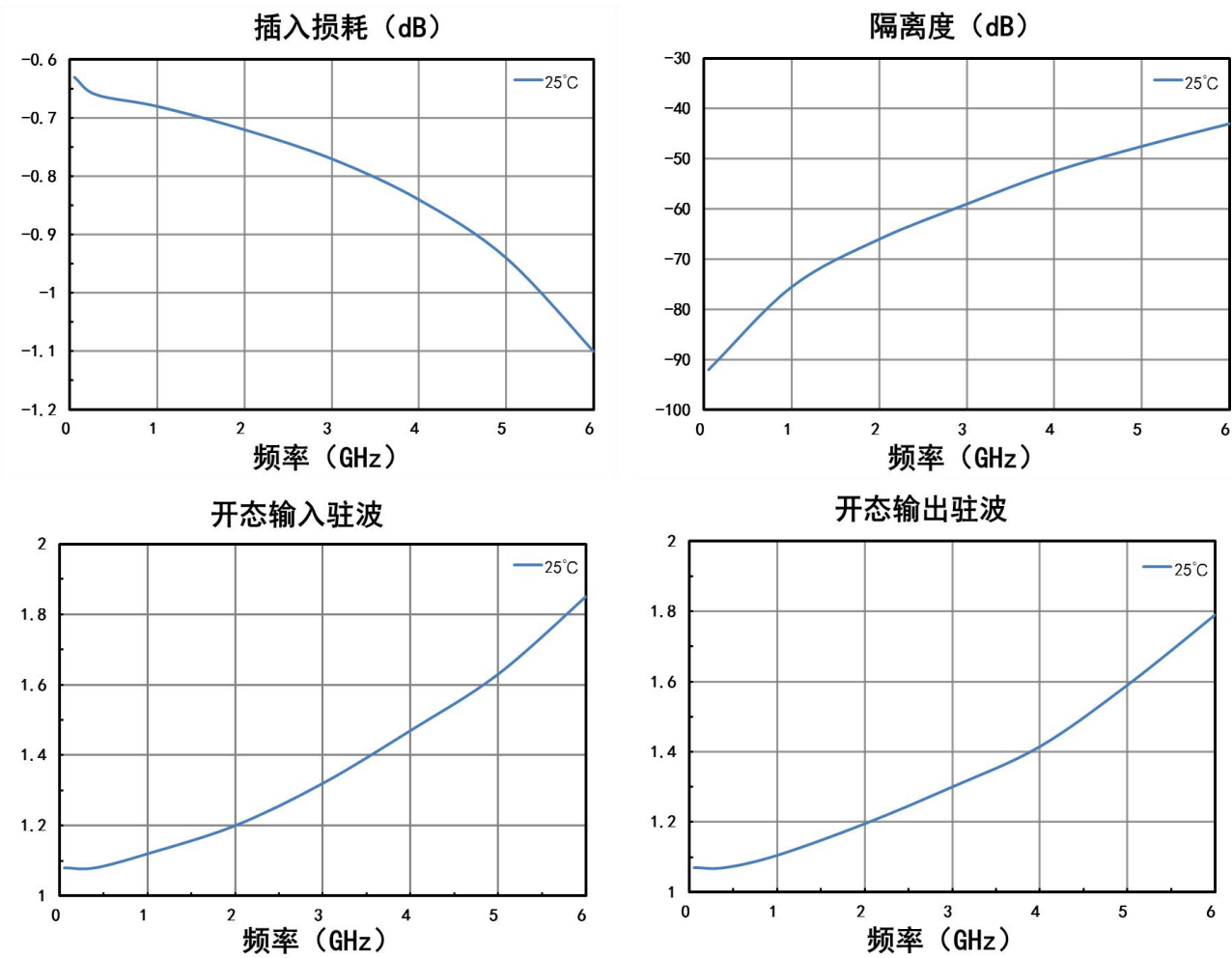
真值表: (0: 0V, 1: +3.3V)

控制输入		通断状态	
EN	Ctrl	RFC-RF1	RFC-RF2
0	0	OFF	ON
0	1	ON	OFF
1	0	OFF	OFF
1	1	OFF	OFF

推荐装配图:


注: 未标注的键合焊盘不需要连接

典型测试曲线：



产品使用注意事项：

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。